デュアルパワー N チャンネル MOSFET

ELM56802WSA-S

■概要

ELM56802WSA-S は低入力容量、低電圧駆動、低オン抵抗という特性を備えた大電流デュアルパワー MOSFET です。

■特長

- Vds=30V
- Id=4.0A
- Rds(on) = 28mΩ (Vgs=10V)
- Rds(on) = 32mΩ (Vgs=4.5V)

■絶対最大定格値

特に指定なき場合、Ta=25℃

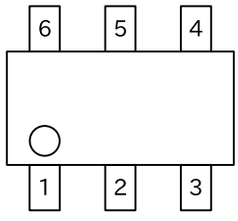
項目		記号	規格値	単位
ドレイン - ソース電圧		Vds	30	V
ゲート - ソース電圧		Vgs	±20	V
連続ドレイン電流 (Tj=150℃)	Ta=25℃	Id	4.0	A
	Ta=70℃		2.8	
パルス・ドレイン電流		Idm	18	A
最大許容損失	Tc=25℃	Pd	2.0	W
	Tc=70℃		1.3	
動作接合部温度		Tj	150	℃
保存温度範囲		Tstg	-55 ～ 150	℃

■熱特性

項目	記号	Typ.	Max.	単位
最大接合部 - 周囲温度	Rθja		120	℃/W

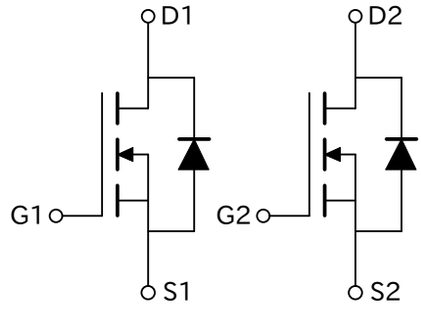
■端子配列図

SOT-26(TOP VIEW)



端子番号	端子記号
1	GATE1
2	SOURCE2
3	GATE2
4	DRAIN2
5	SOURCE1
6	DRAIN1

■回路



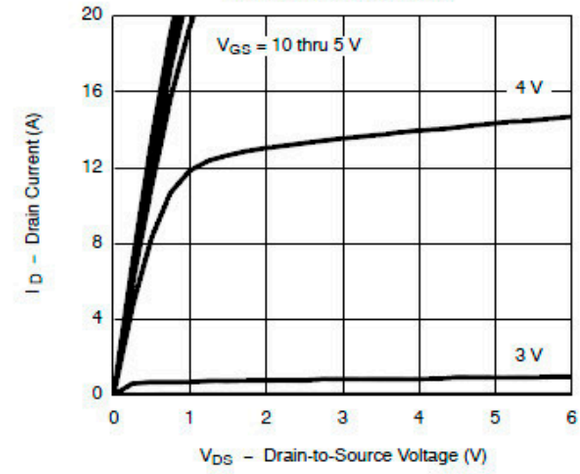
■電気的特性

特に指定なき場合、Ta=25℃

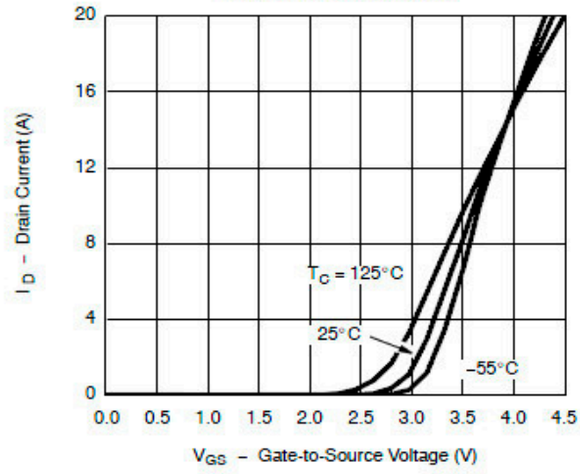
項目	記号	条件		Min.	Typ.	Max.	単位
静的特性							
ドレイン - ソース降伏電圧	BVdss	Id=250μA, Vgs=0V		30			V
ゼロ・ゲート電圧ドレイン電流	Idss	Vds=24V Vgs=0V				1	μA
			Ta=85℃			30	
ゲート漏れ電流	Igss	Vds=0V, Vgs=±20V				±100	nA
ゲート・スレッシュホールド電圧	Vgs(th)	Vds=Vgs, Id=250μA		1.0		2.0	V
オン状態ドレイン電流	Id(on)	Vgs=10V, Vds≧4.5V		10			A
ドレイン - ソースオン状態抵抗	Rds(on)	Vgs=10V, Id=4.0A			20	28	mΩ
		Vgs=4.5V, Id=2.8A			24	32	
順方向相互コンダクタンス	Gfs	Vds=4.5V, Id=2.5A			8		S
ダイオード順方向電圧	Vsd	Is=1.6A, Vgs=0V			0.8	1.2	V
最大寄生ダイオード連続電流	Is					1.7	A
動的特性							
入力容量	Ciss	Vgs=0V, Vds=15V f=1MHz			320		pF
出力容量	Coss				70		pF
帰還容量	Crss				30		pF
スイッチング特性							
総ゲート電荷	Qg	Vgs=10V, Vds=15V Id≡2.6A			3.0	4.5	nC
ゲート - ソース電荷	Qgs				1.6		nC
ゲート - ドレイン電荷	Qgd				0.6		nC
ターン・オン遅延時間	td(on)	Vgs=10V, Vds=15V, Id≡1A RL=15Ω, Rgen=6Ω			8	12	ns
ターン・オン立ち上がり時間	tr				12	18	ns
ターン・オフ遅延時間	td(off)				15	30	ns
ターン・オフ立ち下がり時間	tf				8	15	ns

■標準特性と熱特性曲線

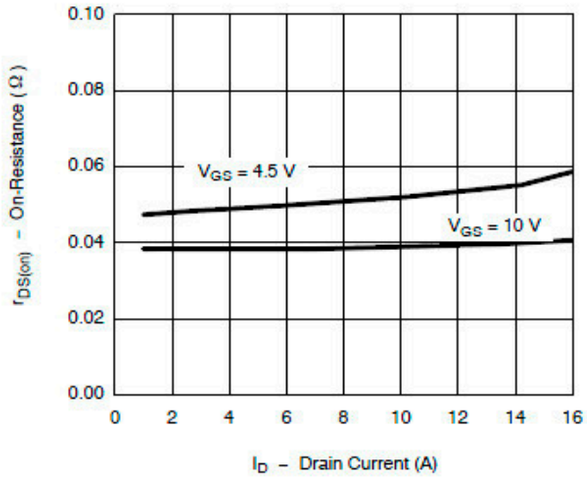
Output Characteristics



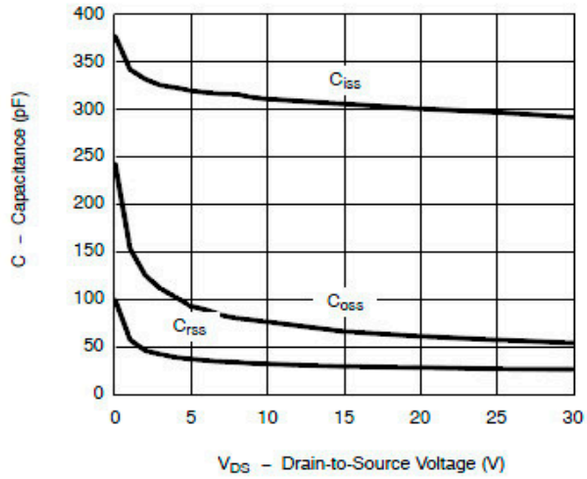
Transfer Characteristics



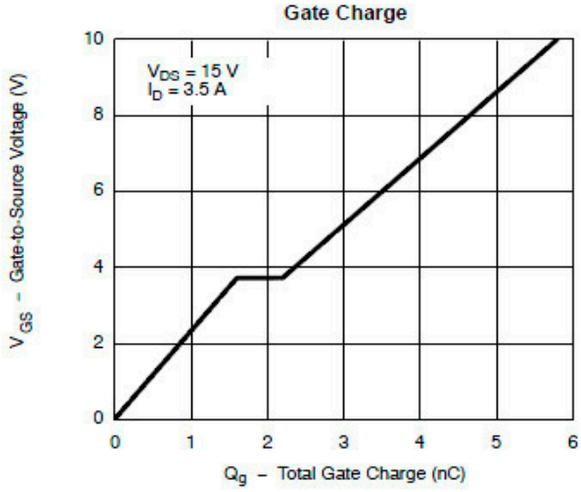
On-Resistance vs. Drain Current



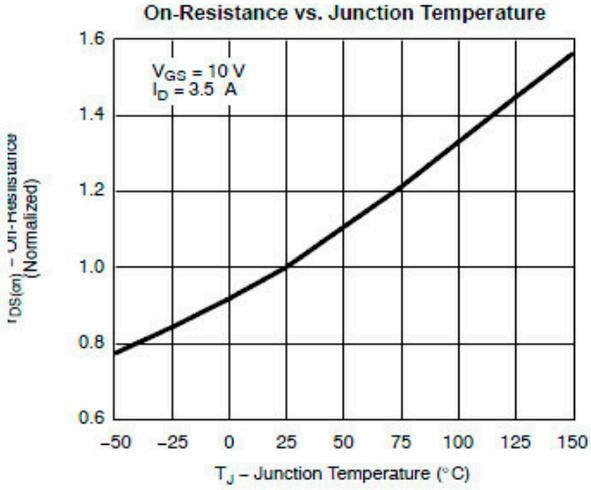
Capacitance



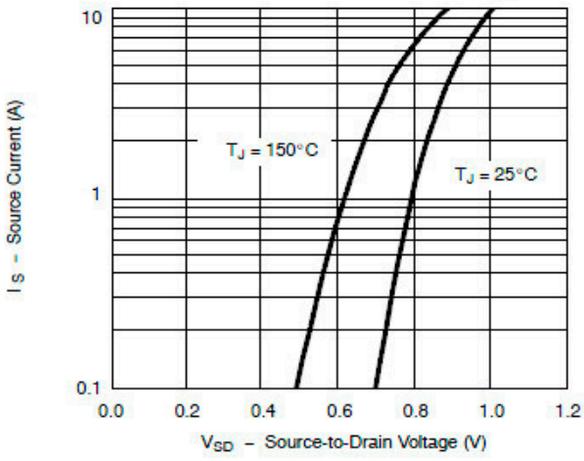
Gate Charge



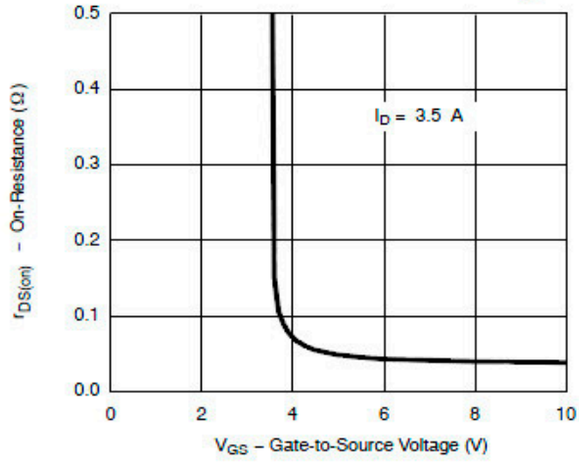
On-Resistance vs. Junction Temperature



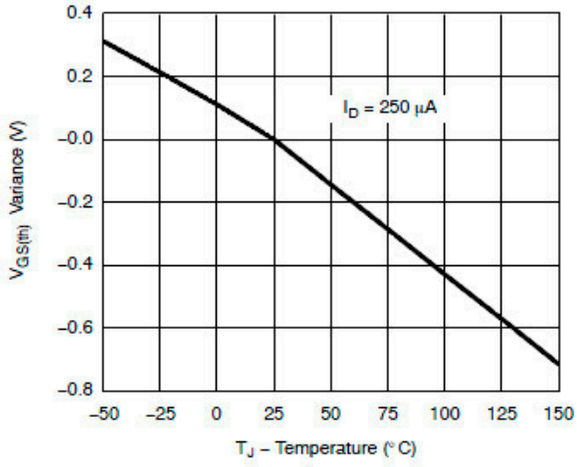
Source-Drain Diode Forward Voltage



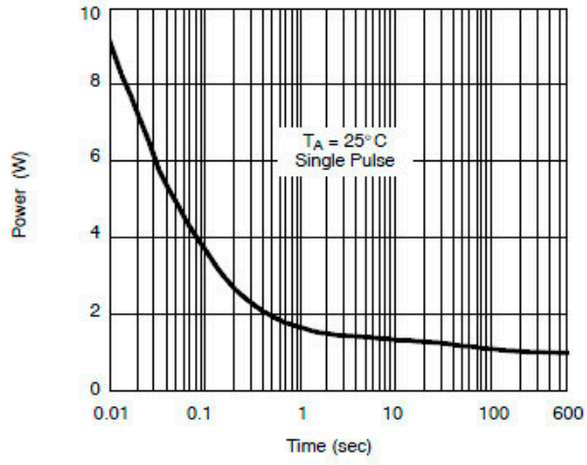
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage



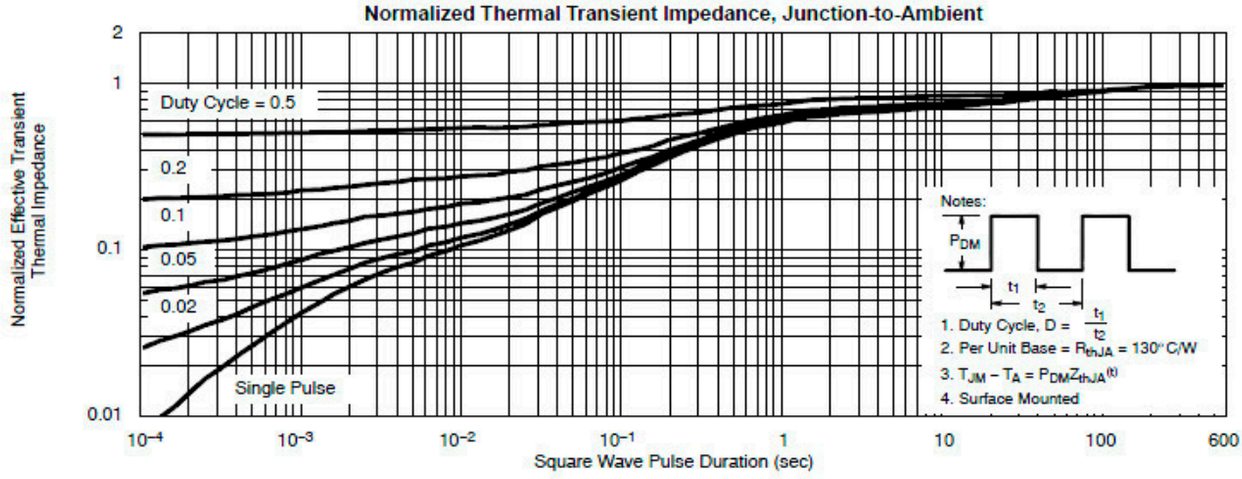
Threshold Voltage



Single Pulse Power

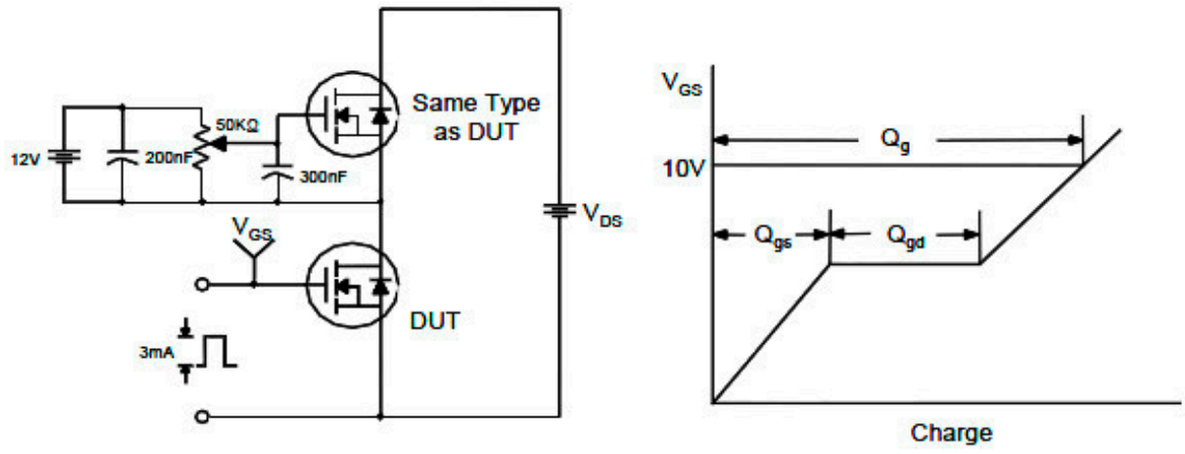


Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient

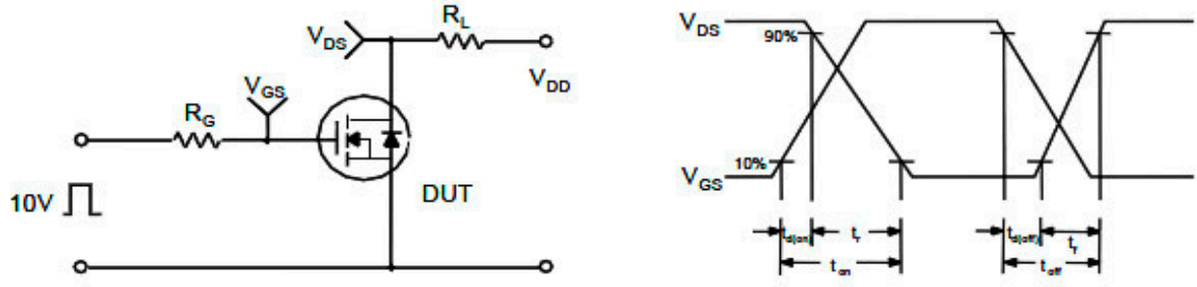
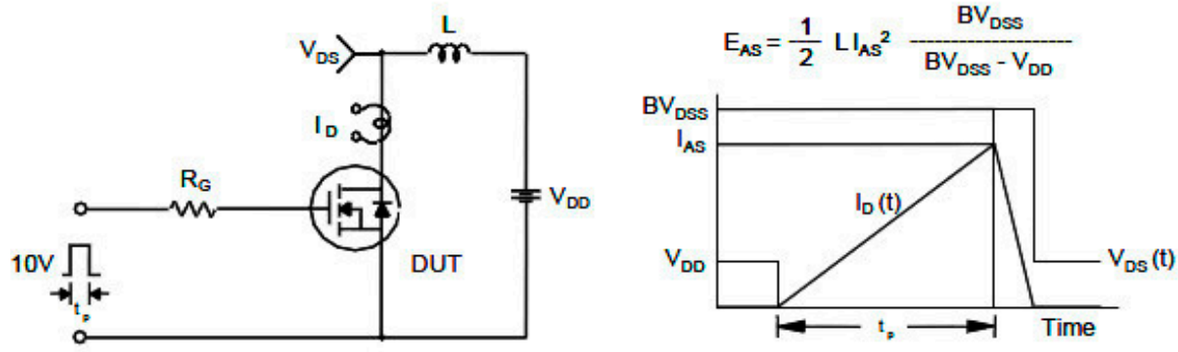


■テスト回路と波形

Gate Charge Test Circuit & Waveform



Resistive Switching Test Circuit & Waveforms



Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms